

2メガビットFRAM

MB85R2001 / MB85R2002

製品概要

FRAMは強誘電体をメモリセルに採用した不揮発性メモリです。従来の不揮発性メモリにくらべ、書き換え速度が速い、書き換え回数が多いという特長を持っています。さらに内部での電源昇圧も不要なため、高速動作で低消費電力が要求される機器などに最適なメモリです。

富士通では約5億個のFRAM製品の出荷実績を持っており、今回量産レベルでは最大容量となる2メガビット製品の販売を開始しました。

2メガビット 平行インタフェースFRAM

新製品

型格	MB85R2001	MB85R2002
ビット構成	256Kワード×8ビット	128Kワード×16ビット
書き込み/読み出し回数	10 ¹⁰ 回 (100億回)	
動作電源電圧	+3.0~+3.6 V	
動作温度範囲	-20~+85 °C	
アクセスタイム	100 ns	
データ保持期間	10年間	
パッケージ	TSOP-48	



MB85R1002
(1MビットFRAM)

1メガビット製品MB85R1001/1002と同一パッケージであるため、必要なメモリ容量に応じて1メガビットと2メガビットのいずれかを選ぶことが出来ます。



MB85R2002
(2MビットFRAM)

技術のアピールポイント

FRAMの特長

- ⌘ 不揮発性
 - ⌘ 高速書き換え
 - ⌘ 書き換え回数が多い
 - ⌘ 書き込み電圧が低い
- リフレッシュ不要、電池不要
消去時間不要、ライトサイクルタイム=リードサイクルタイム
10¹⁰回（100億回）
3.0V、内部昇圧不要

製品ラインナップ

単体FRAM製品ラインナップ

■パラレルインタフェース

型格	FRAM容量	電源電圧	アクセス タイム	動作温度 範囲	データ リテンション	パッケージ
MB85R256H	256Kビット (32K×8)	2.7～3.6V	70ns	-40～+85°C	10年 @70°C	SOP-28 TSOP-28
MB85R1001	1Mビット (128K×8)	3.0～3.6V	100ns	-20～+85°C	10年 @55°C	TSOP-48
MB85R1002	1Mビット (64K×16)	3.0～3.6V	100ns	-20～+85°C	10年 @55°C	TSOP-48 FBGA-48
MB85R2001	2Mビット (256K×8)	3.0～3.6V	100ns	-20～+85°C	10年 @55°C	TSOP-48
MB85R2002	2Mビット (128K×16)	3.0～3.6V	100ns	-20～+85°C	10年 @55°C	TSOP-48

■シリアルインタフェース(SPI)

型格	FRAM容量	電源電圧	クロック スピード	動作温度 範囲	データ リテンション	パッケージ
MB85RS256	256Kビット (32K×8)	3.0～3.6V	15MHz	-20～+85°C	10年 @55°C	SOP-8

富士通株式会社

電子デバイス事業本部 システムマイクロ事業部 マーケティング部
〒163-0721 東京都新宿区西新宿2-7-1新宿第一生命ビル TEL:03-5322-3383 FAX:03-5322-3386
URL <http://jp.fujitsu.com/microelectronics/>